## A1008

A1008はNIM1幅に8chものスペクトロスコピアンプを搭載したモジュール です。波形整形はアクティブフィルタ方式を採用し、理想のガウス整形に近 づけております。最新の低雑音FETを利用したディスクリート増幅回路を採 用しており、入力雑音特性を4µV以下に抑えております。アクティブゲー テット方式のベースラインレストアラも搭載しているので、高計数率などの 測定にもご利用できます。A1008は特にHPGe半導体検出器を用いた測定に おいて、優れた分解能と直線性を実現することが可能です。

## 主な特徴

ゲイン	1~750倍
波形整形	セミガウス整形 ピーキングタイム2.2T, パルス幅6T
雑音特性	入力換算4µV以下 2µs時 ゲイン≥100
積分非直線性	< ±0.05% 2µs時
ベースライン レストアラ	アクティブゲーテット方式オートスレッショルド
高計数率特性	ピークの広がり最大15% 2µs, 入力計数率50kps時

## 仕様

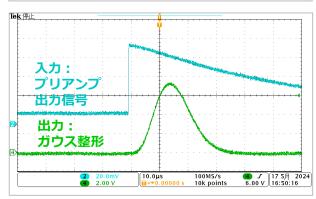
回路数	8チャンネル
入力極性	正/負 内部基板のSWにより設定
アッテネータ	×0.1/×1.0 内部基板のジャンパーにより切替
CoarseGain	×20/×50/×100/×200/×500 内部基板のSWにより設定
FineGain	×0.5~×1.5 パネル取付けポテンショメータにより設定
PZ ADJ	40μs〜∞ パネル取付けポテンショメータにより設定
オフセット電圧	±40mV パネル取付けポテンショメータにより設定
ShapingTime	0.5/2/6µs 内部基板のSWにより設定
入力特性	8チャンネルLEMOコネクタ レンジ:±1.5 V, 入力インピーダンス:1 kΩ
出力特性	8チャンネルLEMOコネクタ 正極ユニポーラ 0-10V, 駆動電流:45mA
プリアンプ電源	D-Sub9 ±12V, ±24V(NIM規格準拠)内蔵
前面	IN:入力LEMOコネクタ OUT:出力LEMOコネクタ F.G:ファインゲイン調整ポテンショメータ P.Z:ポールゼロ調整ポテンショメータ D.C:オフセット電圧調整ポテンショメータ
背面	プリアンプ電源用D-sub9ピンコネクタ
消費電力	+12V (最大200mA), -12V (最大180mA) +24V (最大220mA), -24V (最大200mA) NIMビン電源コネクタより
寸法・重量	NIM1幅 34(W) x 221(H) x 249(D) mm *突起物除<,約980g





背面





※写真はイメージです。

※記載内容は予告なく変更することがあります。

## 株式会社テクノエーピー

〒312-0012茨城県ひたちなか市馬渡2976-15

TEL: 029-350-8011 FAX: 029-352-9013

info@techno-ap.com



